文章编号:1006-9941(2019)06-0456-09

Ni/Cu复合多层膜电爆炸等离子体发射光谱特性及飞片推动性能

杨 爽,孙秀娟,王万军,付秋菠

(中国工程物理研究院化工材料研究所,四川 绵阳 621999)

摘 要: 为探索复合多层膜爆炸箔电爆炸的作用机理,开展了 Ni/Cu 复合多层膜爆炸箔性能研究。采用电化学沉积方法制备了相同厚度的 Ni/Cu 复合多层膜(调制周期分别为 200 nm/300 nm 和 300 nm/400 nm)及纯 Cu、Ni 金属膜,通过等离子体发射光谱特性测试分析,计算获得了不同放电电流条件下不同结构的 Ni/Cu 复合多层膜、纯 Cu、Ni 金属膜电爆炸等离子体电子温度。通过匹配加速膛、飞片进行了爆炸箔推动飞片的 PDV速度测试和分析,获得了不同放电电流条件下 Ni/Cu 复合多层膜、纯 Cu、Ni 金属膜爆炸箔推动飞片进行了爆炸箔推动飞片的 PDV速度测试和分析,获得了不同放电电流条件下 Ni/Cu 复合多层膜、纯 Cu、Ni 金属膜爆炸箔推动飞片性能。研究结果表明:在电流为 2.5 kA时,(Ni₂₀₀Cu₃₀₀)₈和(Ni₃₀₀Cu₄₀₀)₅Ni₃₀₀电爆炸等离子体发射光谱强度以及等离子体电子温度均高于纯 Cu 和纯 Ni,说明 Ni/Cu 复合材料在相同条件下电爆炸储能密度更高;在电流为 2.5 kA时,Ni/Cu 复合材料中的 Ni开始对等离子体推动飞片起促进作用,(Ni₂₀₀Cu₃₀₀)₈和(Ni₃₀₀Cu₄₀₀)₅Ni₃₀₀爆炸箔推动飞片的加速时间更长,最终速度均高于纯 Cu爆炸箔。 关键词: Ni/Cu 复合多层膜;电爆炸等离子体;发射光谱;飞片

中图分类号: TI45 文献标志码: A

DOI:10.11943/CJEM2018346

1 引言

爆炸箔起爆器(EFIs)是一种具有高安全性和可靠 性的火工品,由爆炸箔、飞片、加速膛和炸药组成。在 爆炸箔起爆器作用过程中,爆炸箔起着能量转换的关 键作用,是影响冲击片雷管起爆性能的关键元件,其中 国内外的爆炸箔材料大多以纯铜为主^[1-3]。随着工程 应用小型化和低能化的发展,亟需找到一种可以降低 冲击片雷管起爆能量的爆炸箔新材料。国内外学者尝 试将含能复合膜应用于爆炸箔材料,以期提高爆炸箔 等离子体的输出能力,主流纳米含能复合薄膜为 Al/Ni^[4-9]。Morris CJ等^[4]对比了相同厚度的Al/Ni复 合薄膜和Cu爆炸箔驱动飞片的能力,指出多层膜驱动 飞片的动能高于Cu箔。蒋洪川等^[7]研究在Cu桥箔上 集成Al/Ni复合薄膜,发现Cu/Al/Ni复合爆炸箔电爆

收稿日期: 2018-12-05;修回日期: 2019-03-13
网络出版日期: 2019-05-09
基金项目:国家自然科学基金资助(11872342)
作者简介:杨爽(1987-),女,硕士,主要从事 EFIs 集成设计开发研
究 。e-mail:baicaishuangr@163.com
通信联系人: 付秋菠(1977-),女,博士,主要从事 EFIs 集成设计开
发研究。e-mail: fuqiubo@caep.cn
引用本文: 杨爽,孙秀娟,王万军,等,Ni/Cu复合多层膜电爆炸等离子体发射;

炸的阈值电压比纯Cu箔低,电爆炸温度比纯Cu箔高。 王窈等^[8-9]进一步研究了Al/Ni复合爆炸箔的电和能 量输出特性,结果表明Al/Ni复合爆炸箔比纯Cu箔和 纯Ni箔的爆发电压高,爆发时间短,吸收能量高,驱动 飞片速度也更高。以上试验结果均表明Al/Ni含能复 合薄膜有利于优化现有EFI系统。但是,上述研究没 有Al/Ni复合材料与纯Al的电爆炸性能对比分析,实 验数据无法分析获得Al/Ni电爆炸性能优于Cu箔的 准确原因,即复合爆炸箔的作用机理尚不明确。

已知 Cu 和 Ni 具有相同的面心立方体晶体结构, 原子大小也基本相同(Cu 124 µm,Ni 120 µm)^[10-12], Ni/Cu 复合材料不存在合金化反应,因此为了探索复 合爆炸箔的作用机理,本研究采用 Ni/Cu 复合材料作 为爆炸箔,与纯 Cu 和纯 Ni 箔进行对比,研究了电爆炸 等离子体发射光谱特性及飞片推动性能。采用等离子 体发射光谱^[13-14]及飞片速度 PDV 测试手段,对比了不 同结构的 Ni/Cu 复合多层膜和纯 Cu、Ni 金属膜的等离 子体发射光谱谱线强度以及推动飞片速度曲线特征。

2 实验部分

2.1 样品制备及表征

采用电化学沉积工艺进行金属薄膜的制备。首先

引用本文:杨爽,孙秀娟,王万军,等. Ni/Cu复合多层膜电爆炸等离子体发射光谱特性及飞片推动性能[J]. 含能材料,2019,27(6):456-464. YANG Shuang, SUN Xiu-juan, WANG Wan-jun, et al. Plasma Spectrograph and Driving Flyer Properties of Electrically Exploded Ni/Cu Multilayers[J]. *Chinese Journal of Energetic Materials*(*Hanneng Cailiao*),2019,27(6):456-464.

Chinese Journal of Energetic Materials, Vol.27, No.6, 2019 (456-464)

在玻璃基底(PYREX7740)上磁控溅射一层厚约 100 nm的Ge层作为导电层,然后分别电化学沉积调 制周期为300 nm/400 nm和200 nm/300 nm的Ni/Cu 复合多层膜。Ni/Cu复合多层膜采用交替沉积Ni层 和Cu层的方式:调制周期为300 nm/400 nm时交替 沉积5次,最后沉积一层300 nm的Ni膜,记为 (Ni₃₀₀Cu₄₀₀)₅Ni₃₀₀;调制周期为200 nm/300 nm时交 替沉积8次,记为(Ni₂₀₀Cu₃₀₀)₈。纯Cu膜和Ni膜为一 次性沉积至约4 μm。对制备好的Ni/Cu复合薄膜进 行了SEM及XRD测试表征。

2.2 等离子体发射光谱特性测试方法

通过测试等离子体的发射光谱,利用 Boltzmann 图谱法^[15]计算电爆炸等离子体的电子温度。已知等 离子体在满足局部热力学平衡(Local Thermodynamic Equilibrium,LTE)^[16]条件下,等离子体中各粒子在 其束缚能级上按 Boltzmann分布,同一电离级两条光 谱线的强度关系可表示为:

$$\frac{I_{mn}(2)}{I_{mn}(1)} = \frac{A_{mn}(2)g_{m}(2)\lambda_{1}}{A_{mn}(1)g_{m}(1)\lambda_{2}} \times \exp\left[-\frac{E_{m}(2) - E_{m}(1)}{KT}\right]$$
(1)

式中,标号1、2代表不同的谱线, A_{mn} 为相应谱线的跃 迁几率, s^{-1} , g_m 为上能级的统计权重, E_m 是相应上能级 能量, cm^{-1} , λ 为波长,nm, $K=1.3806504\times10^{-23}$,为玻 尔兹曼常数, $J \cdot K^{-1}$ 。在求电子温度时,以其中某条谱 线 $I_{mn}(1)$ 做基准,其他谱线的强度 $I_{mn}(2)$ 与 $I_{mn}(1)$ 相 比,再取对数,则式(1)可写为:

$$\ln\left(\frac{\lambda_{2}I_{mn}(2)/I_{mn}(1)}{A_{mn}(2)g_{m}(2)}\right) = -\frac{E_{m}(2) - E_{m}(1)}{KT} + c_{0}$$
(2)

式中, c_0 为常数。由式(2)可知,只需作谱线相对强度的对数值与 E_m 的 Boltzmann图,求出其斜率(-1/KT),便可确定电子温度T,K。

计算 Ni/Cu、Cu 等离子体电子温度选用的铜原子 谱线及相关光谱物理参数^[17]见表1。

表1 Cul发射光谱谱线的相关物理参数^[17]

 Table 1
 Physical parameters of Cul emission spectrum

 lines^[17]

wavelength / nm	$E_{\rm m}$ / cm ⁻¹	A _{mn} / 10 ⁷ s ⁻¹	g _m
458.697	62948.260	3.2	6
510.554	30783.697	0.2	4
515.324	49935.195	6	4
570.024	30783.697	0.024	4

Note: E_m is the energy of upper level. A_{mn} is the transition probability. g_m is the partition coefficient associated with the excited level.

计算 Ni 等离子体电子温度选用的镍原子谱线及 相关光谱物理参数^[17]见表 2。

表2 Nil发射光谱谱线的相关物理参数^[17]

Table 2	Physical	parameters	of	Nil	emission	spectrum
lines ^[17]						

wavelength / nm	$E_{\rm m} / {\rm cm^{-1}}$	A _{mn} / 10 ⁷ s ⁻¹	$g_{ m m}$
438.287	54251.308	0.15	7
452.314	22102.325	3.2e-8	9
463.303	49158.480	0.0078	11
483.118	49777.569	1.6	7

等离子体发射光谱测试采集原理示意图如图1所 示。测试系统主要包含两部分:爆炸箔放电测试电路和 光谱信号采集分析系统,其中放电回路主要包含电子开 关VCS、0.47 μF薄膜电容和爆炸箔,爆炸箔表面焊接 铜箔作为电极,采用高压电源(PS350/5000 V-25 W) 为电容充电,罗氏线圈(PEM CWTMini 30B)测量放电 回路电流并用示波器监测,信号发生器(Agilent 33500B)用于触发VCS。光谱信号采集分析系统主要



图1 等离子体发射光谱采集原理示意图

Fig.1 Schematic diagram of the plasma emission spectrometry acquisition

CHINESE JOURNAL OF ENERGETIC MATERIALS

包含光纤探测器、光谱仪(Shamrock 303i A,采用 Andor DH720-18F-03型ICCD)和计算机。在与爆炸箔 表面的法线方向观测光谱信号,光谱信号经光纤采集 传输至光谱仪再输入到计算机进行分析。通过同步机

(DG545)实现放电回路和光谱仪的同步延时。

2.3 飞片速度 PDV 测试方法

采用光子多普勒测速仪(PDV)进行飞片速度测量,测试示意图如图2所示。



图 2 飞片速度 PDV 测试示意图 Fig.2 PDV diagram for the flyer speed test

测速仪采用波长为1550 nm的激光作为光源,采 用微型光纤探头作为末端传感器。激光器输出的光被 1×2光纤分束器分成2路,一束光经过环形器1端口从 环形器2端口出射,再由光纤探头射向飞片,从飞片反 射回来的光由同一探头收集进入环形器2端口,然后 从环形器3端口出射,到达2×1光纤耦合器中。分束 器分出来的另一束光经过一个衰减器后进入2×1光纤 耦合器,与信号光发生光学混频干涉。当飞片运动时, 由于多普勒效应,信号光频率产生与飞片运动速度成 正比的偏移,导致干涉光频率发生正比于飞片速度的 变化。最后由光电探测器获取混频信号,并由高速数 字示波器(Agilent DSA-X93204A)记录下干涉光的频 率变化,即可计算获得飞片运动的速度历程。

根据光的干涉理论,干涉波形信号可表示为: $I(t) = I_0(t) + I_d(t) +$

$$2\sqrt{I_{0}(t)I_{d}(t)}\cos\left\{2\pi\int_{0}^{t}\left[f_{d}(t)-f_{0}(t)\right]dt+\varphi_{0}\right\}(3)$$

式中, $I_0(t)$ 为参考光光强, $cd;I_d(t)$ 为靶面回光光强, $cd;f_0(t)$ 为参考光频率, $Hz;f_d(t)$ 为信号光频率, $Hz;\varphi_0$ 为初始相位角。式(3)等号右边的前两项为直流分 量,第3项为带有与飞片运动速度相关的频率变化的交 流分量。由第3项表达式可知,飞片不动, $f_d(t)=f_0(t)$; 飞片运动,则在某一特定时刻可得到二者的频率差为 $f_d(t)-f_0(t)$,对以该时刻为中心时刻的短时波形信号进 行短时傅里叶变换(STFT)之后,频谱能量主要集中在 $f_d(t)-f_0(t)$ 频率处,即用短时傅里叶变换从时频能量谱 上通过分辨出能量集中频段,可辨别出该中心时刻以 $f_d(t)-f_0(t)$ 为特征频率的信息。由多普勒频移原理 $f_d(t)-f_0(t)=2v(t)/\lambda_0$ (4)

$$v(t) = 1/2[f_d(t) - f_0(t)]/\lambda_0$$
 (5)
式中, $v(t)$ 为飞片运动速度, $m \cdot s^{-1}, \lambda_0$ 为中心波长, nm_0

即获得特征频率之后,经线性转换便获得了特征速度。

3 结果与讨论

3.1 Ni/Cu复合爆炸箔制备

Ni/Cu复合薄膜SEM测试结果如图3所示。由图3





图3 Ni/Cu复合多层膜扫面电镜图

Fig.3 SEM micrographs of the Ni/Cu multilayers

可以看出,Ni和Cu层间的分界比较清晰,Cu层的厚 度控制较好,基本保持一致,但是Ni层的厚度均一性 较差。由图3a还可以看出,在Cu层中有较多泡状结 构,导致Cu层与Ni层的交界不均匀,从而造成Ni金 属层均一性变差,同时也会降低金属膜的密度。

Ni/Cu复合薄膜XRD测试结果如图4所示。Ni/Cu 复合薄膜在43.35°、44.51°、50.51°、51.83°和74.23° 处有五个明显的衍射峰,这五个明显的特征衍射峰分 别与Cu(111)、Ni(111)、Cu(200)、Ni(200)和Cu(220) 晶面相对应,而不同调制周期的Ni/Cu复合薄膜X射 线衍射峰与面心立方体Cu和面心立方体Ni的衍射峰 基本一致,这说明制备的Ni/Cu复合薄膜具有较好的 结晶度,其晶型为面心立方体。



图 4 Ni/Cu复合多层膜XRD图谱 Fig.4 XRD patterns of the Ni/Cu multilayers

制备好的薄膜采用皮秒激光加工进行图形化,最 终成为爆炸箔,(Ni₂₀₀Cu₃₀₀)₈样品照片如图5所示。加 工的爆炸箔桥区为方形,尺寸为0.4 mm×0.4 mm。一 片直径4寸的玻璃片上可加工出54片爆炸箔样品,相 比于化学刻蚀,样品制备效率较高。采用微电阻计测 量了Ni/Cu复合爆炸箔及纯Cu、纯Ni爆炸箔电阻,结 果统计如表3所示。



图 5 图形化(Ni₂₀₀Cu₃₀₀)。复合爆炸箔 Fig.5 Pictures of the (Ni₂₀₀Cu₃₀₀)。 exploding foil

由表3可以看出,纯Cu爆炸箔电阻最小,纯Ni爆 炸箔电阻最大,(Ni₂₀₀Cu₃₀₀)₈和(Ni₃₀₀Cu₄₀₀)₅Ni₃₀₀电阻

介于二者之间。

表 3 Ni/Cu复合爆炸箔及纯Cu、纯Ni爆炸箔电阻 Table 3 The electrical resistance of the Ni/Cu composites, pure Cu and pure Ni exploding foil

exploding foil	number	average resistance / m Ω	standard deviation / m Ω
(Ni ₂₀₀ Cu ₃₀₀) ₈	15	34.0	2.1
$(Ni_{300}Cu_{400})_5Ni_{300}$	14	34.0	1.7
Cu	13	20.2	1.5
Ni	12	75.9	8.9

3.2 等离子体发射光谱特性测试

按照图1进行了爆炸箔等离子体发射光谱测试, 放电电流设为1.5 kA、2.0 kA和2.5 kA。将采集光谱 时刻相对于放电电流零点时刻的时间作为延迟时间。 为研究复合爆炸箔的时间分辨发射光谱,在不同放电 电流下,分别选择延迟时间1000 ns、1200 ns和 1400 ns,设置快门速度为200 ns。Ni/Cu复合爆炸 箔、纯Cu爆炸箔和纯Ni爆炸箔的发射光谱测试结果 如图6所示。

图 6 可以看出: $(Ni_{200}Cu_{300})_{8}$ 和 $(Ni_{300}Cu_{400})_{5}Ni_{300}$ 发射光谱兼具纯 Cu 和纯 Ni 的谱线特征;随着放电电流升高,四种爆炸箔等离子发射光谱谱线强度均升高; 在相同放电电流和延迟时间下,四种爆炸箔中 Ni 的发 射光谱谱线强度最低;时间延迟相同时,放电电流为 1.5 kA,发射光谱谱线强度排序为Cu~ $(Ni_{300}Cu_{400})_{5}Ni_{300}$ > $(Ni_{200}Cu_{300})_{8}$ >Ni,放电电流为 2.0 kA,发射光谱谱线强 度排序为 Cu~ $(Ni_{200}Cu_{300})_{8}$ > $(Ni_{300}Cu_{400})_{5}Ni_{300}$ >Ni,放 电 电 流 为 2.5 kA,发射光谱谱线强度排序为 Cu>Ni。

为了更清楚地观察不同爆炸箔样品中发射光谱谱 线强度的变化规律,首先对比了(Ni₂₀₀Cu₃₀₀)₈、 (Ni₃₀₀Cu₄₀₀)₅Ni₃₀₀和纯Cu发射光谱中较强的几条谱线 (Cu II 461.966 nm、Cu I 510.554 nm 和Cu I 515.324 nm),结果如表4所示。

由表4可以看出:对于(Ni₂₀₀Cu₃₀₀)₈爆炸箔,当放 电电流从1.5 kA升高到2.0 kA时CuI和CuII 谱线强 度提升最大,约300%以上;对于(Ni₃₀₀Cu₄₀₀)₅Ni₃₀₀爆 炸箔,当放电电流从2.0 kA升高到2.5 kA时CuI和 CuII 谱线强度提升最大,约100%以上;对于纯Cu爆 炸箔,当放电电流从1.5 kA升高到2.0 kA时CuI和 CuII 谱线强度提升最大,约150%以上。以上结果说 明,(Ni₂₀₀Cu₃₀₀)₈和纯Cu箔在2.0 kA时爆发比较充分,





 $\textbf{Fig.6} \quad \text{The plasma emission spectroscopic curves of the } (Ni_{200}Cu_{300})_8, (Ni_{300}Cu_{400})_5Ni_{300}, \ Cu \ and \ Ni_{300}Cu_{400})_5Ni_{300}, \ Cu \ and \ Ni_{300}Cu_{400})_5Ni_{300}Cu_{400})_5Ni_{300}Cu_{40}$

discharge current /kA	sample	delay time /ns	Cull 461.966 nm	Cul 510.554 nm	Cul 515.324 nm
		1000	2515	1892	4233
	(Ni ₂₀₀ Cu ₃₀₀) ₈	1200	1434	2290	2822
		1400	613	1029	1308
		1000	2193	2374	2798
1.5	(Ni ₃₀₀ Cu ₄₀₀) ₅ Ni ₃₀₀	1200	3745	4908	5712
		1400	1412	1746	2043
		1000	2970	3136	3731
	Cu	1200	3877	4583	5509
		1400	1012	2069	2603
		1000	8156	8308	8824
	(Ni ₂₀₀ Cu ₃₀₀) ₈	1200	10171	11171	11958
		1400	7351	9152	11127
		1000	5756	6030	6616
2.0	$(Ni_{300}Cu_{400})_5Ni_{300}$	1200	6650	7016	7673
		1400	3106	4501	5133
		1000	10603	10613	11698
	Cu	1200	9835	11688	13380
		1400	4988	8651	9876
		1000	19306	16929	17509
	(Ni ₂₀₀ Cu ₃₀₀) ₈	1200	20474	19720	20491
		1400	14486	15127	14842
		1000	17834	15105	15214
2.5	(Ni ₃₀₀ Cu ₄₀₀) ₅ Ni ₃₀₀	1200	14641	13946	13659
		1400	14486	15030	14842
		1000	17003	13995	15402
	Cu	1200	12108	12229	13003
		1400	10416	11577	12659

表4 Cull 461.966 nm、Cul 510.554 nm 和 Cul 515.324 nm 谱线随时间变化

Table 4 The spectral line strength of Cull 461.966 nm, Cul 510.554 nm and Cul 515.324 nm changes with delay time

而(Ni₃₀₀Cu₄₀₀)₅Ni₃₀₀则是在2.5 kA时爆发比较充分。

进一步对比分析了(Ni₂₀₀Cu₃₀₀)₈、(Ni₃₀₀Cu₄₀₀)₅Ni₃₀₀ 和Ni中Nil谱线随时间的变化规律。由于(Ni₂₀₀Cu₃₀₀)₈、 (Ni₃₀₀Cu₄₀₀)₅Ni₃₀₀中CuI光谱较强,湮灭了大部分NiI 谱线,仅有NiI 463.303 nm和483.118 nm谱线可以 分辨出来,两条谱线随时间的变化情况如表5所示。

由表 5 可以看出:对于(Ni₂₀₀Cu₃₀₀)₈爆炸箔,当放 电电流从 1.5 kA升高到 2.0 kA时 Ni I 谱线强度提升 最大,约 400% 以上;对于(Ni₃₀₀Cu₄₀₀)₅Ni₃₀₀爆炸箔,当 放电电流从 2.0 kA升高到 2.5 kA时 Ni I 谱线强度提 升最大,约 200% 以上;对于纯 Ni爆炸箔,当放电电流 从 2.0 kA升高到 2.5 kA时 Ni I 谱线强度提升最大,约 300% 以上。以上结果说明,(Ni₂₀₀Cu₃₀₀)₈在 2.0 kA时 爆发比较充分,而(Ni₃₀₀Cu₄₀₀)₅Ni₃₀₀和纯 Ni 箔则是在 2.5 kA时爆发比较充分,与表4分析结论一致。

根据发射光谱谱线,可以对等离子体的电子温度

进行分析。以延迟时间为1200 ns为例,根据式(2), 以Cu I 515.324 nm 谱线作基准,绘出表1中谱线相 对强度值与对应谱线跃迁上能级能量的 Boltzmann 图,由最小二乘法拟合得到斜率。图7为延迟1200 ns 时不同放电条件下(Ni₂₀₀Cu₃₀₀)₈发射光谱的 Boltzmann图。

图7a、图7b和图7c中拟合直线的斜率(-1/KT)分别为 (-7.4105×10¹⁸)、(-7.20316×10¹⁸)和(-7.05056×10¹⁸), 则电子温度分别为9773.9 K、10055.3 K和10272.9 K, 拟合度均达90%以上。

采用相同方法可以获得不同延迟时间不同放电电流下(Ni₂₀₀Cu₃₀₀)₈、(Ni₃₀₀Cu₄₀₀)₅Ni₃₀₀和Cu发射光谱Boltzmann 图拟合直线的斜率。同样,以NiI 463.303 nm 谱线 作基准,绘出表 2 中谱线相对强度值与对应谱线跃迁上能级能量的Boltzmann图,由最小二乘法拟合得到 斜率。根据拟合直线的斜率(-1/KT)可计算获得等离

含能材料

子体的电子温度,结果如表6所示。

表 5	Ni I	463.303	nm和4	483.118	nm谱	F线阶	植时间变位	Ł	
Table	5 T	he specti	al line	strength	of N	iΙ	463.303	nm	and
483.1	18 nr	n change	s with o	delay tim	ie				

discharge current / kA	sample	Delay time / ns	Ni I 463.303 nm	Ni I 483.118 nm
		1000	892	1176
	(Ni ₂₀₀ Cu ₃₀₀) ₈	1200	668	917
		1400	406	491
		1000	975	1412
1.5	(Ni ₃₀₀ Cu ₄₀₀) ₅ Ni ₃₀₀	1200	1392	2437
		1400	640	995
		1000	375	372
	Ni	1200	931	660
		1400	448	384
		1000	3586	4694
	(Ni ₂₀₀ Cu ₃₀₀) ₈	1200	4051	5817
		1400	2710	3802
		1000	2911	4133
2.0	(Ni ₃₀₀ Cu ₄₀₀) ₅ Ni ₃₀₀	1200	2746	4178
		1400	1152	1986
		1000	2386	1678
	Ni	1200	2190	1427
		1400	1654	1095
		1000	9730	12224
	(Ni ₂₀₀ Cu ₃₀₀) ₈	1200	8780	12205
		1400	5968	8937
		1000	10162	13369
2.5	(Ni ₃₀₀ Cu ₄₀₀) ₅ Ni ₃₀₀	1200	7147	9931
		1400	5968	8937
		1000	10181	6759
	Ni	1200	9095	6481
		1400	4735	3193

表6 等离子体电子温度计算结果	
-----------------	--

 Table 6
 Results of calculated electron temperature

sample	discharge current	calculated electron temperature / K			
	/ kA	1000 ns	1200 ns	1400 ns	
	1.5	8608	9773.9	9276.9	
(Ni ₂₀₀ Cu ₃₀₀) ₈	2	10203.5	10055.3	9827.3	
	2.5	10624.1	10272.9	10242.4	
(Ni ₃₀₀ Cu ₄₀₀) ₅ Ni ₃₀₀	1.5	9804.6	9888.5	9797.5	
	2	10466.9	10391.9	10126.7	
	2.5	11327.5	10990.6	10966.1	
	1.5	10128.7	10053.9	9442.1	
Cu	2	10471.1	10360.4	9994.8	
	2.5	10532.7	10308.9	10166.5	
	1.5	2943.7	2870.3	2856.7	
Ni	2	2847.5	2859.2	2865.1	
	2.5	2859.3	2846.2	2855.2	

由表6可以看出:Ni电爆炸等离子体电子温度较低(<3000 K),Ni/Cu复合材料电爆炸等离子体电子温度与Cu在同一量级(10⁴ K),且在1.5 kA和2.0 kA时,Ni/Cu复合材料电爆炸等离子体温度整体比Cu低,当电流升高到2.5 kA时,Ni/Cu复合材料电爆炸等离子体温度变得比Cu高。

综合上述实验结果,分析认为:当放电电流较低时 (1.5 kA和2.0 kA),Ni/Cu复合爆炸箔中的Ni电爆炸 不充分,而Ni会吸收部分能量,从而导致Ni/Cu复合 爆炸箔等离子体的能量比纯Cu低,原子发射光谱强度 和等离子体电子温度都比Cu低;当放电电流较高时 (2.5 kA),Ni/Cu复合爆炸箔中的Ni电爆炸比较充分, Ni吸收的能量贡献到Ni/Cu复合爆炸箔等离子体中, 使Ni/Cu复合爆炸箔等离子体的能量比纯Cu高,即原 子发射光谱强度和等离子体电子温度都比Cu高。





Fig.7 Boltzmann diagram of the $(Ni_{200}Cu_{300})_8$ emission spectrum when the delay time is 1200 ns

3.3 飞片速度 PDV 测试

采用不锈钢加速膛(长 0.4 mm,孔径为 Φ 0.6 mm)、 聚 酰 亚 胺 飞 片 (厚 50 μ m),与 (Ni₂₀₀Cu₃₀₀)₈、 (Ni₃₀₀Cu₄₀₀)₅Ni₃₀₀、纯 Cu 和纯 Ni 爆炸箔进行匹配,按 照图 2 所示在放电电流为 1.5、1.75、2.0、2.25 kA 和 2.5 kA条件下进行 PDV 飞片速度测试,飞片速度随时 间变化如图 8 所示。

由图8可以看出:随着放电电流升高,(Ni200Cu300)8、

(Ni₃₀₀Cu₄₀₀)₅Ni₃₀₀、纯Cu和纯Ni推动飞片的速度均升高,即推动飞片能力提高;在放电电流较低时(1.5 kA和 1.75 kA),Cu爆炸箔推动飞片速度最高;放电电流为 2.0 kA时,(Ni₂₀₀Cu₃₀₀)₈爆炸箔推动飞片速度超过了Cu; 放电电流为2.25 kA时,(Ni₂₀₀Cu₃₀₀)₈、(Ni₃₀₀Cu₄₀₀)₅Ni₃₀₀ 和纯Cu推动飞片速度相当;放电电流为2.5 kA时, (Ni₂₀₀Cu₃₀₀)₈和(Ni₃₀₀Cu₄₀₀)₅Ni₃₀₀爆炸箔推动飞片加速 时间更长,使得飞片速度均超过了纯Cu₅



图8 不同放电电流下PDV飞片速度测试曲线

Fig.8 PDV test curves of theflyer speed at different discharge current

4 结论

基于等离子体发射光谱和飞片速度 PDV 测试手段,获得了(Ni₂₀₀Cu₃₀₀)₈、(Ni₃₀₀Cu₄₀₀)₅Ni₃₀₀、纯 Cu 和纯 Ni等离子体发射光谱特性及推动飞片性能,主要得出 以下结论:

(1)(Ni₂₀₀Cu₃₀₀)₈和(Ni₃₀₀Cu₄₀₀)₅Ni₃₀₀发射光谱兼 具纯Cu和纯Ni的谱线特征;放电电流为2.5 kA时, (Ni₂₀₀Cu₃₀₀)₈和(Ni₃₀₀Cu₄₀₀)₅Ni₃₀₀发射光谱谱线强度均 高于Cu₅

(2)在本研究实验条件下,纯Ni电爆炸等离子体电 子温度较低(<3000 K),Ni/Cu复合材料电爆炸等离子 体电子温度与Cu在同一量级(10⁴ K),电流为2.5 kA 时,Ni/Cu复合材料电爆炸等离子体温度比Cu高。

(3)放电电流为 2.5 kA 时, Ni/Cu 复合爆炸箔推动 飞片加速时间更长, 使得飞片速度均超过了纯 Cu。

(4)当放电电流较高时(2.5 kA),Ni/Cu复合爆炸 箔中的Ni电爆炸比较充分,对Ni/Cu复合爆炸箔电爆 炸具有促进作用。

参考文献:

- [1] 陈楷, 徐聪, 朱朋, 等. 加速膛与复合飞片对集成爆炸箔起爆器 性能的影响[J]. 含能材料, 2018, 26(3): 273-278.
 CHEN Kai, XU Cong, ZHU Peng, et al. Effect of barrel and multilayer flyer on the performances of micro chip exploding foil initiator [J]. Chinese Journal of Energetic Materials (Hanneng Cailiao), 2018, 26(3): 273-278.
- [2] 房旷,陈清畴,付秋菠,等.集成爆炸箔起爆器的制备和飞片驱动能力表征[J].含能材料,2016,24(9):892-897.
 FANG Kuang, CHEN Qing-chou, FU Qiu-bo, et al. Fabrica-

含能材料

tion and flyer driving capability characterisation of an integrated exploding foil initiator[J]. *Chinese Journal of Energetic Materials*(*Hanneng Cailiao*), 2016, 24(9): 892–897.

- [3] 袁士伟,曾庆轩,冯长根,等.冲击片雷管飞片参数设计与估算
 [J].火工品,2003,(4):18-20.
 YUAN Shi-wei, ZENG Qing-xuan, FENG Chang-gen, et al. The designing and estimating of flying plate parameters of slapper detonator[J].*Initiators and Pyrotechnics*,2003,(4):18-20.
- [4] Morris C J, Marya B, Zakar E, et al. Rapid initiation of reactions in Al/Ni multilayers with nanoscale layering[J]. *Journal* of Physics & Chemistry of Solids, 2010, 71(2): 84–89.
- [5] 黄娜, 唐洪佩, 黄寅生, 等. 冲击片雷管爆炸箔的制备与电爆性 能[J]. 含能材料, 2014, 22(4): 514-520.
 HUANG Na, TANG Hong-pei, HUANG Yin-sheng, et al. Preparation and electrical performance of exploding foil in slapper detonator [J]. *Chinese Journal of Energetic Materials* (*Hanneng Cailiao*), 2014, 22(4): 514-520.
- [6] 王涛,曾庆轩,李明愉,等. Al/Ni反应多层膜的电爆炸及驱动 性能研究[J].火工品,2016,(5):1-5.
 WANG Tao, ZENG Qing-xuan, LI Ming-yu, et al. Explosion and flyer-driving performance of Al/Ni reactive multilayers[J]. *Initiators and Pyrotechnics*,2016,(5):1-5.
- [7] ZHANG Yu-xin, JIANG Hong-chuan, ZHAO Xiao-hui, et al. Characteristics of the energetic microinitiator through integrating Al/Ninanomultilayers with Cu film bridge[J]. Nanoscale Research Letters, 38(12): 1–6.
- [8] 王窈,孙秀娟,郭菲,等. Al/Ni爆炸箔电爆特性及驱动飞片能力研究[J].火工品,2016,(3):5-8.
 WANG Yao, SUN Xiu-juan, GUO Fei, et al. Study on Electrical characteristic and flyer driven ability of Al/Ni exploding foil
 [J]. Initiators and Pyrotechnics, 2016,(3): 5-8.
- [9] WANG Yao, SUNXiu-juan, JIANG Hong-chuan, et al. Investigation of electrically heated exploding foils in reactive Al/Ni multilayer [J]. Propellants Explos. Pyrotech., 2018, 43: 923–928.
- [10] WU Dong-fang, TAN Qing-qing, HU Li-chong. Shape-con-

trolled synthesis of Cu-Ni nanocrystals[J]. *Materials Chemistry and Physics*, 2018, 206(1): 150–157.

- [11] FU Zheng-rong, ZHANGZheng, MENG Li-fang, et al. Effect of strain rate on mechanical properties of Cu/Ni multilayered composites processed by electrodeposition [J]. *Materials Science & Engineering A*, 2018, 726(1): 154–159.
- [12] WANG Chuan-jie, WANG Hai-yang, GENG Fang-fang, et al. Interactive effects of microstructure and interface on tensile deformation behaviors of Cu/Ni clad foils[J]. *Materials Science* & Engineering A, 2018, 714 –(1): 14–24.
- [13] 赵小侠,罗文峰,张相武,等.基于LIBS技术的黄铜等离子体特 征参量的研究[J].激光技术,2013,37(1):93-96.
 ZHAO Xiao-xia, LUO Wen-feng, ZHANG Xiang-wu, et al. Measurement of brass plasma parameters based on laser-induced breakdown spectroscopy[J]. Laser Technology, 2013, 37(1):93-96.
- [14] 傅院霞,徐丽,葛立新,等.激光诱导镍等离子体电子温度的时间演化特性[J].蚌埠学院学报,2016,5(5):30-37.
 FU Yuan-xia, XU Li, GE Li-xin, et al. Investigation on the time evolution of the electron temperature in laser-induced Ni plasma[J]. *Journal of Bengbu University*, 2016, 5(5): 30-37.
- [15] 李澜,陈冠英,张树东,等.激光能量对激光诱导Cu等离子体特征辐射强度,电子温度的影响[J].原子与分子物理学报,2003,20(3):343-346.
 LI Lan, CHEN Guan-ying, ZHANG Shu-dong, et al. Effects of laser energy on electron temperature and the emission spectra intensities of copper plasma ablated with laser [J]. Chinese Journal of Atomic and Molecular Physics, 2003, 20(3): 343-346.
- [16] Calzada M D, Moisan M, Gamero A, et al. Experimental investigation and characterization of the departure from local thermodynamic equilibrium along a surface-wave-sustained discharge at atmospheric pressure[J]. *Journal of applied physics*, 1996, 80(1): 46–55.
- [17] NIST atomic spectra database[OL], https://www.nist.gov/pml/ atomic-spectra-database, 2018.

Plasma Spectrograph and Driving Flyer Properties of Electrically Exploded Ni/Cu Multilayers

YANG Shuang , SUN Xiu-juan , WANG Wan-jun, FU Qiu-bo

(Institute of Chemical Materials, CAEP, Mianyang 621999, China)

Abstract: To explore the exploding mechanism of composite multilayers, the properties of Ni/Cu multilayer exploding foil were studied. Ni/Cu composite multilayers (modulation period 200 nm/300 nm and 300 nm/400 nm, respectively), pure Cu and Ni films with the same thickness were prepared by electrochemical deposition. The plasma emission spectroscopy was measured. Under different discharge current conditions, the electron temperature of electrically exploded plasma of Ni/Cu composite multilayers with different structures, pure Cu and Ni films was calculated, respectively. After matching barrels and flyers with exploding foils, the velocity of flyer driven by different exploding foils was measured by PDV method. The performance of the exploding foils driving flyer under different discharge current conditions were obtained. The results show the plasma emission spectroscopy intensity and electron temperature of $(Ni_{200}Cu_{300})_8$ and $(Ni_{300}Cu_{400})_5Ni_{300}$ is higher than pure Cu and Ni at discharge current of 2.5 kA, indicating the Ni/Cu composites have higher electrically exploding energy density at the same condition. The Ni in Ni/Cu composites promotes the plasma to push flyer forward, resulting in the accelerating time and final velocity of flyer driven by $(Ni_{200}Cu_{300})_8$ and $(Ni_{300}Cu_{400})_5Ni_{300}$ are both higher than those of flyer driven by pure Cu.

Key words: Ni/Cu multilayers; electrically plasma; spectrograph; flyer

 CLC number: TJ45
 Document code: A
 DOI: 10.11943/CJEM2018346

 (责编:美 梅)